

Silicon Diode

TI42

32V / 100mW

DATASHEET

OEM – Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

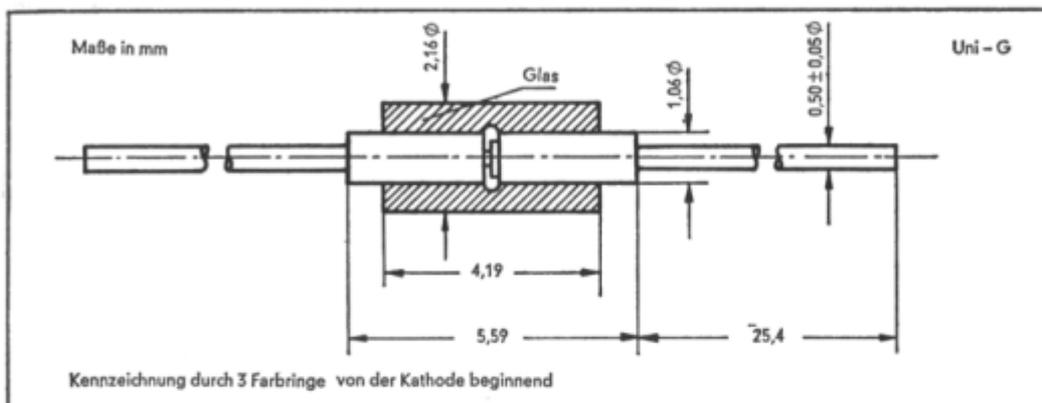
TI42

Diffundierte-Silizium-Trigger-Diode

Lawineneffekt-Schaltdiode für Thyristor-Ansteuerung

Mechanische Daten

Das glaspassivierte Silizium-Kristall ist in einem Glasgehäuse hermetisch abgeschlossen. Hochtemperatur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschlüssen garantieren einen guten Kontakt, selbst bei extremsten Umweltbedingungen.



Absolute Grenzwerte

Mittlere Verlustleistung	100 mW
Spitzenstrom bei 10 s Pulsbreite	1 A

Max. Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$ (wenn nicht anders angegeben)

$I_{(\text{BR})F}$	Vorwärts-Durchbruchstrom	300 μA
$U_{(\text{BR})F}$	Vorwärts-Durchbruchspannung	32 ± 4 V

Min. Änderung der Durchbruchspannung bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

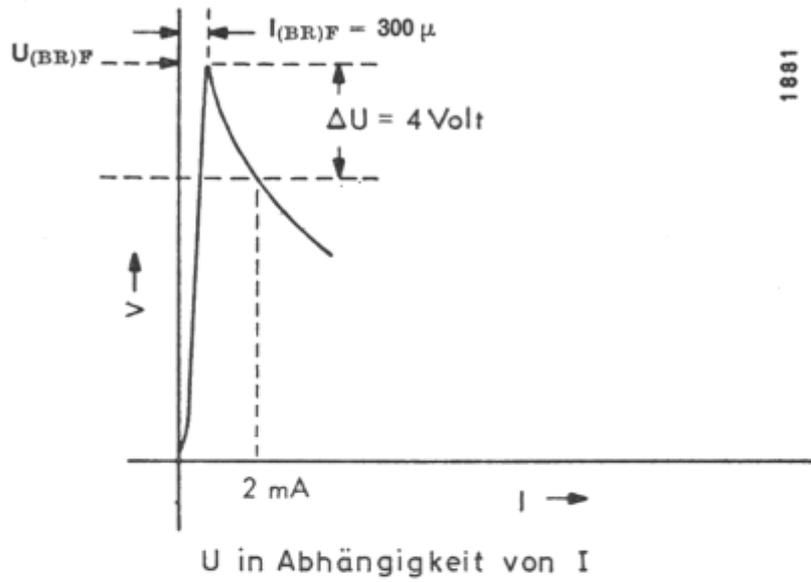
$\Delta U = U_{(\text{BR})F}$ abzüglich der Vorwärtsspannung bei $I_F = 2$ mA	4 V
---	-----

Betriebswerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$

T_K Temperaturkoeffizient der Flußspannung (typ)

0,02

Einheit
%/°C



Für gleichmäßig veränderlichen, symmetrischen Ausgang; für Ersatz von Magnet-Reglern, Regeltransformatoren, Zündspulen, Relais usw.

